# **FUROPEAN PATENT C FICE**

## Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER PUBLICATION DATE

: 04155854 28-05-92

APPLICATION DATE

19-10-90

APPLICATION NUMBER

: 02280925

APPLICANT: HITACHI VLSI ENG CORP;

INVENTOR : OTSUKA KANJI:

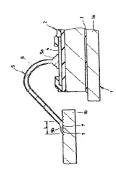
INT.CL.

: H01L 23/50 H01L 21/60

TITLE

: SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT DEVICE AND LEAD FRAME

THEREFOR



ABSTRACT : PURPOSE: To enhance the bonding of a bonding wire to an external lead-out terminal in strength so as to improve a semiconductor integrated circuit device in reliability by a method wherein a bonding pad is electrically connected to the external lead-out terminal with a bonding wire, and a groove is provided to the wire bonded face of an external lead-out terminal.

> CONSTITUTION: One end of a bonding wire 5 is bonded to a bonding pad 4 with a ball bonding 5a. The other end of the bonding wire 5 is bonded to the inner lead 1b of a lead frame 1 with a wedge bonding 5b. The bonding pad 4 is electrically connected with the inner lead 1b with the bonding wire 5. Grooves 7 are provided to the wire bonded face of the inner lead 1b. The wire bonded face is enhanced in effective bonding face, and the bonding wire 5 is bonded to the inner lead 1b through a wedge bonding method, whereby the bonding of the bonding wire 5 to the inner lead 1b can be enhanced in strength.

COPYRIGHT: (C) JPO

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

#### 平4-155854 ⑫公開特許公報(A)

@Int. Cl. 5 H 01 L 23/50 21/60

Ų

識別記号 301

庁内整理番号 8418-4M 6918-4M ❸公開 平成4年(1992)5月28日

6918-4M 3 0 i

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全6頁)

半導体集積回路装置およびそれに用いるリードフレーム ❷発明の名称

寛 治

頭 平2-280925

顧 平2(1990)10月19日

@発明 者

@発 明 者 大 塚 東京都小平市上水本町5丁目20番1号 日立超エル・エ ス・アイ・エンジニアリング株式会社内 東京都青梅市今井2326番地 株式会社日立製作所デバイス

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

⑦出 願 人 日立超エル・エス・・ 東京都小平市上水本町5丁目20番1号

アイ・エンジニアリン

グ株式会社

弁理士 简井 大和 の代 理 人

半導体集兼回路装置およびそれに用いるリード

2. 特許請求の範囲 1. 半導体チップに形成されたポンディングバッ ドと、外部引出用罐子とがポンディングワイヤ

によって電気的に接続されてなる半導体集務回 絡装置であって、割配外部引出用増子のワイヤ 接合面に携を設けたことを特徴とする半導体集

2. 前記ポンディングワイヤはその表面に能線体 が被覆された被覆ワイヤであることを特徴とす

る禁求項し記載の半導体集積回路装置。 3. 前紀外部引出用罐子であるインナーリードの ワイヤ接合面に痛を扱けたことを特徴とする雄 求項1または2記載の半導体集積回路装置に用

いるリードフレーム・ 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、半導体要賛回略装置技術に関し、各 に、ワイヤボンディング方式の半導体集種回路装 誰に適用して有効な技術に関するものである。

ワイヤボンディング方式は、半導体チップのボ ンディングパッドと、パッケージまたはサードフ レームの外部引出用電子とを金(Au)または?

ルミニウム (A8) 等からなるポンティングワイ ヤによって電気的に接続し、半導体チップに形成 された半導体集製回路素子の電極を外部に引き出 す技術である。

ワイヤボンディング方式については、例えば粒 研出版物、1985年6月1日発行、「超しSI テクノロジー」P594~P597に記載があり、 この文献には、ボール・ウェッジボンディング技 術について説明されている。ポール・ウェッジボ ンディングは、半導体チップのポンディングパッ

ドにはボールポンティングを行い、パッケージま たはリードフレームの外部引出用帽子にはウェッ ジボンディングを行う技術である。 ボールボンデ

#### 持期平4-155854 (2)

インブは、ポンディンフワイヤの光電に水素トーナまたは短気トーナ等によりボールを近した状態したが、 そのボールを複雑を物にからでは、ログマイヤと観音を含むとを接合する技術をある。速する ウェッジボングで、短いでは、回避を動かつりまとなる。 フェッシブ・スを関する状態をある。できる ボールでは、回転を動かっています。 ボールでは、回転を動かっています。 ボールでは、回転を動きないできまり、 ボーンプインでは、原発を動きを使える ボーンプインでは、原発を動きを使える ボーンプインでは、ボールでは、ボーンでは、ボールでは、ボーンでは、ボーンでは、ボールでは、ボーンでは、ボー

#### ・ (発明が解決しようとする課題)

ところが、上起従来のワイヤボンディング技術 においては、以下の間確があることを本発明者は 見出した。

すなわち、従来は、ポンディングワイヤと外類 引出用福子との接合強度が、ポンディングワイヤ とポンディングパッドとの接合強度よりも弱い点 について无分な配慮かなされておらず、ポンディ 特開平4-155854 (∠) ングワイヤと外駆引出用塩子との接合強度不足に

起因して半導体製権回路装置の信頼性が低下する 問題があった。

特に、ポンディングワイヤの表面に起線体を観 関した被覆ワイヤにおいては、ポンディングアウ ドラか解された被覆型起線体の成分がポンディンの イヤの指された被置をき込まれる改象を発けること ができず、ポンディングワイヤと外部が出版を との指令を呼び下足し、半導体無機回路装置の母 様性が低下する関節があった。

本見明は上記課題に曾日してなされたものであ り、その目的は、ポンディングワイヤと外部引出 用端子との障合強度を向上させ、半導体無種回転 気質の原格性を向上させることのできる技術を提 供することにある。

本発明の他の目的は、被覆ワイヤと外部引出用 位子との接合後度を向上させ、被覆ワイヤを育す る半導体業種回路装置の信頼性を向上させること のできる技術を提供することにある。

を登明の前記ならびにその他の目的と新規な特

### 趣は、明報書の記述および番件関値から明らかに なるであろう。

### (森騒を解決するための手段)

本様において開示される発明のうち、代表的なものの概要を限単に説明すれば、以下のとおりである。

すなわち、瀬泉畑 I 足載の発明は、半導体チップに形成されたボンディングパッドと、外部引出 用電子とかポンティングワイヤドと、外部引出 接続されてなる半導体無限回路装置であって、 接続部引出用電子のワイヤ経を面に減を致けた非 導体集製回路装置構造とするものである。

#### (作用)

上記した課求項 1 記載の発明によれば、外部引 出用稿子におけるワイヤ技会副の実効接合画験が 様により増大するので、ポンディングワイヤと外 野引出用稿子との接合強度を向上させることがで

また、ポンディングワイヤと外部引出用塩子と をウェッジポンディングにより接合する場合、例 えば外部引出間電子の唐を超音数回動方向に直交またはそれに近い方向に軽在させることにより、 放うエッジボンデスのにがに難し、ポンティングラ すっ物を画に観音した異物や性型重度はすが成 により機械的に研問されるので、ポンティングウ イヤの施性面で服金ができ、ポンディングワイヤの を対面引出用電子との作合検索を何よさせること と外部引出用電子との作合検索を何よさせること

新1回は来発明の一実施所である本導体集機回路装置の要型新報問の、第2回は第1回に示した手間は集集を回路を開発をできる。1回に示したインナーリードル形成された第の新面形状態をデイインナーリードに形成された第の新面形状態をデイインナーリードに形成された第の新面形状態をデオインナーリードに形成された第の形面形状態をデオインナーリードの要が大原の平面形状態のデオインナーリードの要数拡大平面回である。

本実施例の半導体集後回路装置は、被覆ワイヤ ポンディング方式の半導体集後回路装置である。

## 特開平4-155854 (**3)**

取1回に示すように、リードフレーム1のダイ パッド1a上には、半導体チップ2かチップ能会 超3により複合されている。リードフレーム1に 42フロイ等からなり、チップ後会終3に続(A 8)入りエポキン構製等からなる。

半導体チップ 2 は、例えば単結品シリコン (Si) からなり、その主面側には軸壁回路あるいは 半導体メモリ等を接成するための所定の半導体要 種回路素子が形成されている。

また、半毎年チップ2の主面上には、半単体観 機関略菓子の電像を引き出すためのボンディング イン・ドイか出変まれている。ボンディンフバッド イは、例えばAォーSi☆食またはAォーSiっ Cu合金からなり、半単はチップ2の写真辺に約 って質数配置されている。

ポンディングパッド 4 には、ポンディングワイヤ 5 の一幅が、第一ポンディングであるボールボンディング 55 5 a によって接合されている。また メンディングの 7 マヤ 5 の 億幅は、第二ポンティングであるウェッツボンディングの 55 b によってリ ードフレーム1のインナーリード(外部引出用程 デ )1 かに除るされている。 すなわら、本実践的 も を 中等体集機の経験変は、ポンティングパイヤ 5 によって電気的に接続された機能となってる。 ・ボールボンディング加 5 a は、例とば 米 まトー ナまたは 電気トーナーによっ ボンディング つ の一種にボールを形成した後、そのボールをボン ディングパッド 4 に押し付けてポンディングワイヤ 5 とポンディングパット 4 とを接合して形成された解分である。

また、ウェッジボンディング部3ちは、例えば 超音振幅的エネボーおよび熱エネルギーにより ポンディングワイヤ5とボンディングバッド4と を確らして形成された部分である。ウェッジボン ディング部3ちのほとしは、例えば80gm程度、 雑は、例えば70gm度である。

ポンディングワイヤ5は、A u あるいは A e 等からなり、その変態にはポリウレタン削弱あるいはポリイミド開設等からなる絶縁体 6 が試理され

ている。なお、ポンディングワイヤ5の直径は、 例えば30μm程度である。また、インナーリー ド15の幅は、例えば90μm程度、厚さは、例 えば150μm程度である。

ところで、本実施例の中導体集機の粘度室においては、インナーリード I b のワイド接合面に収 の薄了が接けられている。 アなわち、本実的 に起いては、インナーリード I b のワイヤ権合面 に選びを設けたことにより、取ワイヤ権合面の実 対する関係を博士させることができるので、ボン インプワイヤを足インナーリード I b とそり A ソワイヤ 5 とインナーリード I b との権合強度を 消とさせることができるようになっている。

満了の新面形状、平面形状をそれで代第2段、 第3回にディ・第2回にポナように、満了は、例 えば新面V学状に形成されている。漢フの総は、 例えば5μm間度であり、図さは、例えば5μm 以下である。ただし、漢フの新面形状は、V学状に発定される。 例えば暮く図に示すように、リ字状としても良い。 また、本実施例において漂7は、ウェッジボン ディングの際の超音波振動方向と直交またはそれ に近い方向に延在するように設けられている。す なわち、本実施例においては、漢7を超音放振動 方向と直交またはそれに近い方向に軽在させたこ とにより、ウェッジボンディングに際してホンデ ィングワイヤ5の接合面に被着した異物や残留被 腹対等が沸りによって機械的に研削されるように なっている。本実施例において購7の平面形状は、 第3回に示すように、例えばストライプ状に形成 されている。ところで、ワイヤ後合面において溝 7 の占有面積比率が多過ぎるとかえって接合強度 か低くなる。そこで、一概には規定できないが、 ワイヤ接合面に対する誰7の占有面貌比率は、例 えば50%程度以下、すなわち、平坦領域8の占 有面被比率が少なくとも50%程度以上とするこ とが望ましい。また、購7の平面形状は、ストラ イブ状に限定されるものではなく種々変更可能で あり、例えば第5回に示すように、メッシュ状と

## 待開手 4-155854 (4)

しても良い。

摘では、半導体チップをがダイパッド! a 上に 係合される前に、例えばレーザ加工法、電子ビー ム加工法、エッチング加工法あるいはコイニング 法等により形成すれば良い。

このように本実施例によれば、以下の効果を得ることが可能となる。

(1)、インナーリード I bのワイヤ接合面に乗 7 を 設けたことにより、話ワイヤ接合面の実効 除合面 観を順大させることができるので、ポンディング ワイヤ 5 とインナーリード I b との接合機 便を向 上をせることが可能となる。

②、属了の製在方向を組合技術動方向と収支またけをれて近い方向としたことにより、ポンディングワイヤをとインナーリード1 b とをウェッジがディングワスにより除合する際、ポンディングワイヤをの接合面に被乗した貨物を検留に対すって成れのでは、ボンディングワイでの活性面をインナーリード1 b のワイヤトを都に接合することかできるので、ボンディングワイを関に接合することかできるので、ボンディングワークでは、ボンディングワークでは、ボンディングワークでは、ボンディングワークでは、ボンディングワークでは、ボンディングワークでは、ボンディングワークでは、ボンディングワークでは、ボンディングワークでは、ボンディングワークでは、ボンディングワークでは、ボンディングワークでは、ボンディングワークでは、ボンディングワークでは、ボンディングワークでは、ボンボームでは、ボンディングでは、ボンボームでは、ボンディーをは、ボンボームでは、ボンディーをは、ボンディーをは、ボームでは、ボームでは、ボームでは、ボームでは、ボームでは、ボームでは、ボールでは、ボームでは、ボームでは、ボールでは、ボームでは、ボームでは、ボームでは、ボームでは、ボームでは、ボームでは、ボールでは、ボームでは、ボームでは、ボームでは、ボールでは、ボームでは、ボールでは、ボーム

イヤ5とインナーリード1bとの複合強度を向上させることが可能となる。

(5)、上記(11)、②により、設置ワイヤポンディング 方式の半導体機器回路装置における歩割りおよび 危機性を大幅に向上させることが可能となる。

以上、本発明者によってなされた発明を実施的 に基づき具体的に説明したが、本発明は容配実施 例に限定されるものではなく、その要旨を急致し ない範囲で様々変更可能であることはいうまでも

例えば何を実施的においては、年本様キップを リードフレーにのデイバッド上に実施する半導体 機能回路 英雄に 実現・高級 旧した場合について 政 切したが、これに限定されるものではなく、例え ば半導体ナップをバッケージ条 版や配容 形成 形成 パッド上に実施する半導体 無機関級 改正 本 切 で 適用 して し良い。この 場合、パッケージ系 を配慮 基 版 等に没けられた外部 引出 用 係 子の フィ 中能合面に 原子 切ける

また、何起実施例においては、ポンティングワ

イヤとポンディングパッドとをボールポンディングにより検金した場合について関末はボンディングに関末はボンディング マイヤとボンディングパッドとをウェッジボンディングは、シガにより様合しても良い。

また、何記実施例においては、「ボンディングワイヤを被理ウイヤとしたが、これに限定されるものではなく、遺産のボンディングワイヤでも良い。 (発明の効果)

本難において関示される発明のうち、代表的な ものによって再られる効果を簡単に説明すれば、 下記のとおりである。

すなわち、請求項1配数の発列によれば、外部 引出用値子のウイヤ技を前の実効性を組置が廃し より増大し、ポンディングウイヤと外部引出用値 子との接合複数を向上させることができるので、 半等体裏接回額装置の保格性を向上させることが

また、ポンディングワイヤと外部引出用場子と をウェッソポンディングにより接合する場合、例 えば外部引出間電子の席を超音数に動力向に置な またはそれに近い方向に延在させることにより、 筋ウェッジボンディングに関し、ボンディングウ イヤの物会面に観響した異性や検接回線関目等が成 により観視的に開始され、ボンディングウイヤ と外部引出用暗子との指令する半導体表質の の複数性を向上させることが可能となる。 の複数性を向上させることが可能となる。

4、 図面の簡単な技明

第1回は本発明の一実施例である半導体集後回 路装置の要都断面図、

第2図は第1図に示した半導体集費回路装置を 機成するインナーリードの要認拡大断面図、

第 3 図は第 2 図に示したインナーリード先傷の 要部拡大平面図、

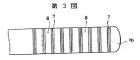
第4四は本発明の他の実施例である半導体最積 回路装置を構成するインナーリードの要和拡大断 原間。

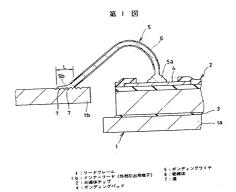
第5回は本発明の他の実施例である半導体集機

15開半4-155851 (5)

# 2 Ø

化喹人 并理士 餠 井 大 3





特勝平4-155854 (日)

